

# Elektronik 1 Dersi

Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi : Murat Duman

Mail: [mduman@ankara.edu.tr](mailto:mduman@ankara.edu.tr)

Ders Kitabı: *Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky-Electronic Devices and Circuit Theory (11th Edition)-Prentice Hall (2012)*

(Bu çalışmadaki şekiller ders kitabından alınmıştır)

Hafta 12

## Bölüm 4. : Uygulama

### Malzeme Listesi:

Silisyum diyot

Zener diyot (10 V'luk)

8 k $\Omega$  direnç, 10 k $\Omega$  direnç, 15 k $\Omega$  direnç, 20 k $\Omega$  direnç, 500 k $\Omega$  direnç, 1 M $\Omega$  direnç

100 k $\Omega$  potansiyometre, 1 M $\Omega$  potansiyometre

2N4401 BJT Transistör

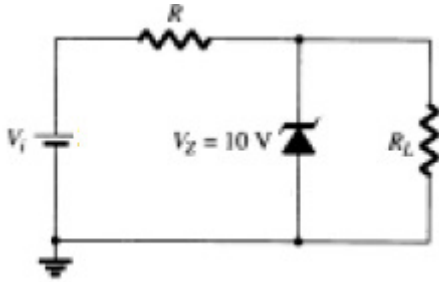
BC337 BJT Transistör

BF245 FET Transistör

Milimetrik kağıt

## Bölüm 4.3. : Deney 3

$V_i=20\text{ V}$ ,  $R=10\text{ k}\Omega$  olmak üzere;  $R_L$ 'nin sırasıyla  $2\text{ k}\Omega$ ,  $8\text{ k}\Omega$ ,  $15\text{ k}\Omega$  and  $20\text{ k}\Omega$  olduğu durumlar için  $V_Z$  ve  $I_Z$ 'nin değerlerini ölçünüz. Ölçülen değerleri teorik olarak bulduğunuz değerlerle kıyaslayınız.



Şekil 4.3. İlgili Şekil